

Procedimento transitorio:

- Per $t \rightarrow 0^-$,
 - calcolare variabile di stato prima dell'inizio del transitorio
 - In questa fase il **condensatore/induttore** si comporta come **circuito aperto/cortocircuito**
 - Sfrutterò nella fase 2 la continuità della variabile di stato
- Per $t \rightarrow 0^+$ (per var. **NON** di stato es. v_x, i_x),
 - (Eventuale chiusura interruttore)
 - Sfrutto continuità variabile di stato:
 $v_C(t_0^-) = v_C(t_0^+)/ i_L(t_0^-) = i_L(t_0^+)$
 - Sostituisco al transitorio GENERATORE IDEALE DI **TENSIONE/ CORRENTE** con valore pari alla variabile di stato appena calcolata

$$E = V_C(t \rightarrow 0^-) \quad I = I_L(t \rightarrow 0^-)$$
- Per $t \rightarrow \infty$ / $t > 0$:
 - Soluzione di tipo esponenziale
 - Formule variabili di stato:

$$V_C(t) = V_{C\infty} + [V_C(0) - V_{C\infty}] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$I_L(t) = I_{L\infty} + [I_L(0) - I_{L\infty}] e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 - Formule per le grandezze **non di stato**:

$$I_C(t) = I_{C\infty} + [I_C(0^+) - I_{C\infty}] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_L(t) = V_{L\infty} + [V_L(0^+) - V_{L\infty}] e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 - Qui, siamo **ancora a regime**: il **condensatore/induttore** si comporta come **circuito aperto/cortocircuito**
 - Cerco la variabile di stato per $t \rightarrow \infty$
 - Cerco τ :
 - Mi serve R_{eq} ai morsetti di dove c'è transitorio
 - Spenso generatori non pilotati**
 - uso **generatore sonda (c.g.)** - cerco corrente che passa sul ramo della sonda in funzione di V_S : $? \rightarrow I_S(V_S)$

$$R_{eq} = \frac{V_S}{I_S(V_S)}$$

D. Calcolo τ :

$$\tau = C \cdot R_{eq} = \frac{L}{R_{eq}}$$

Grafico

- Traccio asintoto
- Sfrutto **proprietà dell'esponenziale**: tangente al grafico in $t = 0$ interseca il valore asintotico dopo $\Delta t = \tau$
- Dopo $t = 5\tau$ la funzione assume valore asintotico

Resistenze e Alimentazioni

Resistenze in parallelo:

- Caso con 2 resistenze:

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

- Caso generale (n resistenze):

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$$

△ NOTA IMPORTANTE - Tensioni di alimentazione

Le tensioni fornite dalle alimentazioni sono le **massime e minime** possibili nel circuito.

I NODI della rete **NON** possono mai avere tensioni:

- Più alte di V_{max} (alimentazione massima)
- Più basse di V_{min} (alimentazione minima)

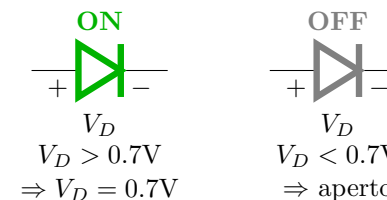
ATTENZIONE: Questo vale per le tensioni dei **NODI** (riferite a massa).

Le **cadute di tensione** (misurate tra due nodi diversi) possono superare questi limiti!

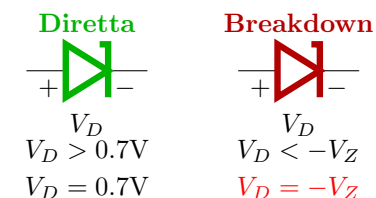
Uso pratico: Fondamentale quando si fanno ipotesi sullo stato dei diodi (ON/OFF). Se un'ipotesi porta un nodo oltre V_{max} o sotto V_{min} , l'ipotesi è **sbagliata**.

Diodi

- Diodo normale:

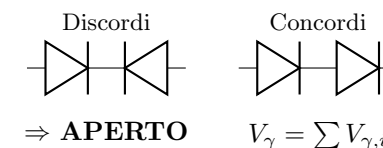


- Diodo Zener:



ATTENZIONE: In breakdown, la tensione $V_D = -V_Z$ ha polarità **opposta** rispetto ai $+0.7V$ della conduzione diretta!

- Configurazioni in serie:



★ TRUCCO PRATICO - Verifica stato diodo:

Quando sei **in un intorno della soglia** ($V_D \approx 0.7V$, anche infinitesimamente superiore), le **correnti sono molto basse**.

\Rightarrow Per verificare se il diodo si accende puoi **ignorare le resistenze in serie** ($I \approx 0 \Rightarrow \Delta V_R \approx 0$).

Uso nei transitori: A fine esercizio, verifica che l'ipotesi sul diodo (ON/OFF) resti valida in:

- \hat{T}^- (istante prima della transizione)
- \hat{T}^+ (istante dopo della transizione)
- $t \rightarrow \infty$ (regime)

Capacità: Formule e Comportamento

1. Tensione del condensatore:

$$V_C(t) = V_C(0^+) + [V_C(\infty^*) - V_C(0^+)] \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

$V_C(0^+)$: iniziale; $V_C(\infty^*)$: a regime; $\infty^* \neq \infty$

2. Corrente: $I_C(t) = C \frac{dV_C(t)}{dt}$

Proprietà: La **corrente** varia **istantaneamente**; La **tensione** NON commuta: $V_C(t_0^-) = V_C(t_0^+)$

★ REGOLA D'ORO - A REGIME

A regime ($t \rightarrow \infty$): $\frac{dV_C}{dt} = 0 \Rightarrow I_C = 0$

Condensatore = CIRCUITO APERTO

Per calcolare $V_C(\infty)$:

1. Sostituisci C con **circuito aperto**
2. Risolvi il circuito semplificato
3. Calcola la tensione nel punto dove c'era C

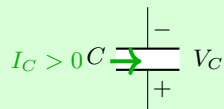
Es: $V \xrightarrow{R_1} \bullet \xrightarrow{R_2} \text{GND} + C \parallel R_2$
 $\Rightarrow V_C(\infty) = V \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ (partitore)

3. Ripple: $\Delta V_{out} = V_{picco} \frac{\Delta T}{\tau} = V_{picco} \frac{T}{f \cdot \tau}$

4. Comportamento fisico ($Q = C \cdot V$; $I = C \frac{dV}{dt}$)

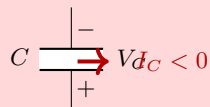
CARICA ($\frac{dV_C}{dt} > 0$): Corrente **ENTRA** ($I_C > 0$)
 Il condensatore accumula energia; $V_C \uparrow$

Corrente ENTRA



SCARICA ($\frac{dV_C}{dt} < 0$): Corrente **ESCE** ($I_C < 0$)
 Il condensatore rilascia energia; $V_C \downarrow$

Corrente ESCE



Regola: $V_C \uparrow \Rightarrow$ CARICA; $V_C \downarrow \Rightarrow$ SCARICA; segno I_C indica verso

Transitori con gradini multipli

Formula tempo centrale \hat{T} :

$$V_C(\hat{T}) = V_C(0^+)_{\hat{T}} + [V_C(\infty^*) - V_C(0^+)_{\hat{T}}] \left(1 - e^{-\frac{\hat{T}}{\tau}}\right)$$

Prassi: segnale rettangolare

salita \rightarrow plateau \rightarrow discesa

Procedimento step-by-step:

1. FASE 1 - Salita

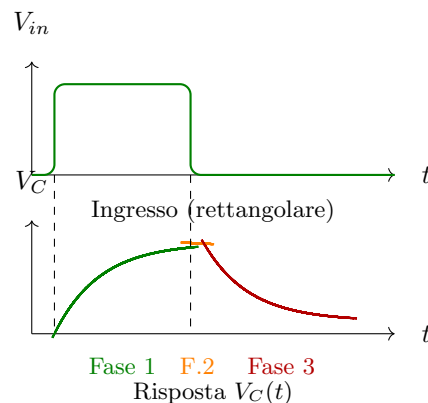
- Analizza $t = 0^-$ (condizioni iniziali)
- $V_C(0^+)$ per continuità
- Determina stato diodi
- Calcola $V_C(\infty^*)$
- Applica formula con τ

2. FASE 2 - Plateau

- Se durata $\gg 5\tau$: regime
- Se durata $< 5\tau$: calcola V_C fine
- Verifica diodi (Box 7)

3. FASE 3 - Discesa

- $V_C(0^+) = V_C(\text{fine plateau})$
- Ridetermina stato diodi
- Nuovo $V_C(\infty^*)$
- Applica formula



Verifica ipotesi stato diodi

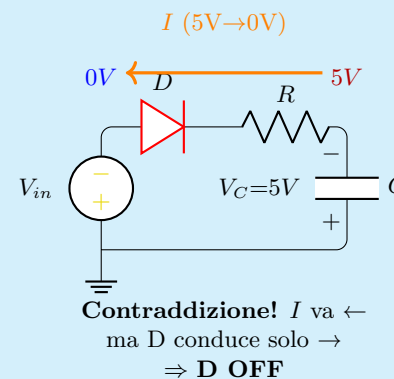
△ VERIFICA FONDAMENTALE

Verifica ipotesi diodo (ON/OFF) rimanga valida per tutto il transitorio

FASE 0: Metodo intuitivo

Regola: I scorre da V_+ a V_-

- 1) $V_C(0^+)$ continuità
- 2) Trova V_{\max}
- 3) I va da V_{\max} a V_{\min}
- 4) Compatibile con diodo?
- 5) No \Rightarrow cambia stato



1. Ipotesi (es: D ON)
2. Risolvi (ON: gen 0.7V; OFF: aperto)
3. Calcola $V_C(t)$
4. Verifica $\forall t$:

ON: $I_D(t) > 0$? No \rightarrow errore

OFF: $V_D(t) < 0.7V$? No \rightarrow errore

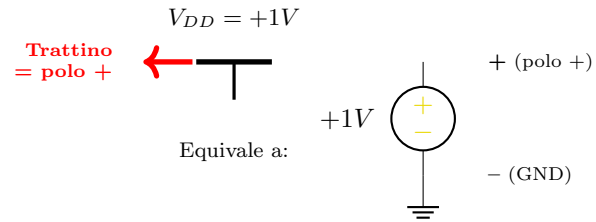
5. Se errore: dividi in 2 fasi (t^* cambio), ricalcola

Notazione alimentazioni

NOTAZIONE ALIMENTAZIONI

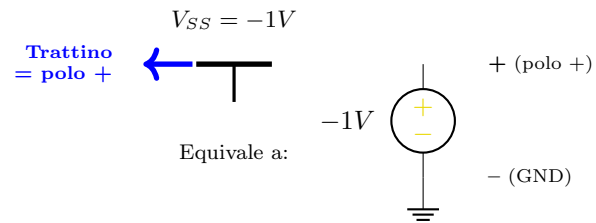
REGOLA D'ORO: Il trattino indica SEMPRE il polo + del generatore, sia con tensione positiva che negativa!

Caso 1: $V_{DD} = +1V$ (alimentazione positiva)



Tensione $+1V \rightarrow$ polo + sul trattino, tutto normale

Caso 2: $V_{SS} = -1V$ (alimentazione negativa)



Tensione $-1V \rightarrow$ polo + è comunque sul trattino!

TRUCCO: Con $V_{SS} = -1V$ puoi ridisegnare il generatore invertendo polarità E segno: diventa $+1V$ con polo + su GND. Utile per evitare tensioni negative nei calcoli.

Formazione del Canale nei MOSFET

1. Zona OFF (o Cutoff):

- Non c'è formazione del canale.
- Il dispositivo è spento e non permette il flusso di corrente tra drain e source.

2. Zona Ohmica (o Triodo):

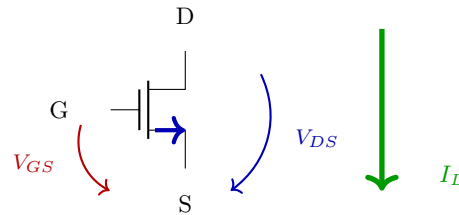
- Si forma un canale.
- Quando il gate è abbastanza polarizzato (cioè $V_{GS} > V_{Tn}$ per nMOS o $V_{GS} < V_{Tp}$ per pMOS), si forma un canale conduttivo tra il drain e il source.
- Il dispositivo si comporta come un **resistore il cui valore varia in base alla tensione V_{GS}** .

3. Zona di Saturazione (o Pinch-off):

- Si forma un canale.
- Il canale diventa "strozzato" o "pinched-off" vicino al drain (per il nMOS) o vicino al source (per il pMOS).
- Anche se la tensione V_{DS} aumenta ulteriormente, la corrente I_D rimane costante.
- Questo comportamento è **analogo a quello di un generatore di corrente**.

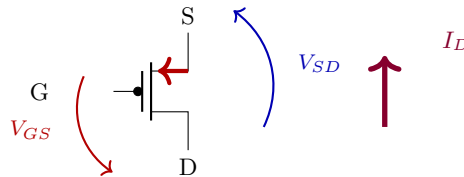
Simboli e convenzioni nMOS/pMOS

nMOS:



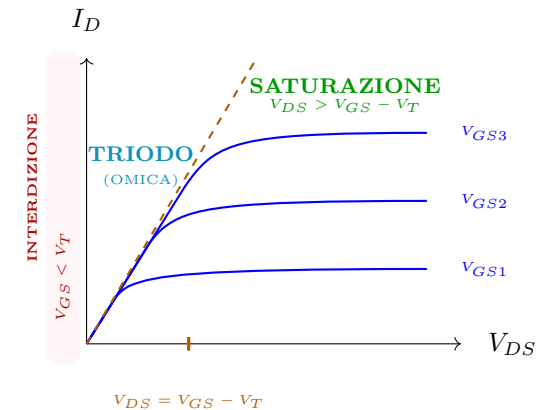
nMOS: Gate a sinistra, Drain in alto, Source in basso
Corrente: Da Drain → Source (verso il basso)

pMOS:



pMOS: Gate a sinistra, Source in alto, Drain in basso
Corrente: Da Source → Drain (verso il basso)
NOTA: Nel pMOS il source è in alto (invertito rispetto a nMOS)!

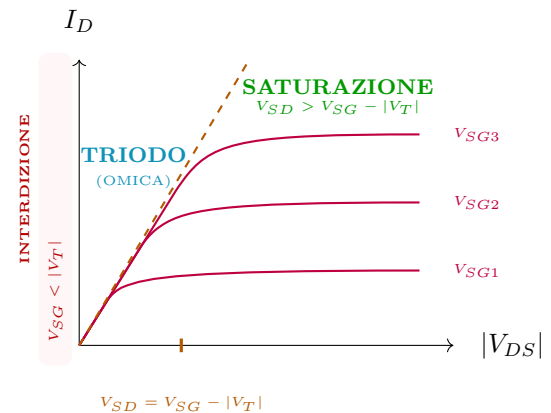
Caratteristica I-V nMOS



Zone di funzionamento:

- INTERDIZIONE:** $V_{GS} < V_T \rightarrow I_D = 0$
- TRIODO:** $V_{GS} > V_T$ e $V_{DS} < (V_{GS} - V_T)$
- SATURAZIONE:** $V_{GS} > V_T$ e $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$

Caratteristica I-V pMOS



Zone di funzionamento:

- INTERDIZIONE:** $V_{SG} < |V_T| \rightarrow I_D = 0$
- TRIODO:** $V_{SG} > |V_T|$ e $V_{SD} < (V_{SG} - |V_T|)$
- SATURAZIONE:** $V_{SG} > |V_T|$ e $V_{SD} > (V_{SG} - |V_T|)$

nMOS - Metodo operativo

PRIMO CONTROLLO: V_{GS} vs V_T

- Se $V_{GS} < V_T \Rightarrow$ MOSFET OFF
 - $I_D = 0$ (circuito aperto)
 - Non c'è conduzione
- Se $V_{GS} > V_T \Rightarrow$ MOSFET ON
 - Proseguire al **SECONDO CONTROLLO**

SECONDO CONTROLLO (solo se ON): V_{DS} vs $(V_{GS} - V_T)$

Tensione di Overdrive:

$$V_{OV} = V_{GS} - V_T$$

- ZONA DI SATURAZIONE:** Se $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_T)^2$$

Nota: La corrente dipende **SOLO** da V_{GS}

- ZONA OHMICA (Triodo):** Se $V_{DS} < (V_{GS} - V_T)$

$$I_D = K_n \left[2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$$

Nota: La corrente dipende da V_{GS} **E** V_{DS}

Formula alternativa:

$$I_D = \frac{1}{2} K_n V_{OV} \left(V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right)$$

Direzione corrente: In nMOS, I_D scorre da **Drain** \rightarrow **Source**

pMOS - Metodo operativo

PROCEDIMENTO OPERATIVO PER pMOS

Step 1: Calcolare $|V_{GS}|$

Step 2: PRIMO CONTROLLO - $|V_{GS}|$ vs $|V_T|$

- Se $|V_{GS}| < |V_T| \Rightarrow$ MOSFET OFF
 - $I_D = 0$ (circuito aperto)
 - Non c'è conduzione
- Se $|V_{GS}| > |V_T| \Rightarrow$ MOSFET ON
 - Calcolare $V_{OV} = |V_{GS}| - |V_T|$
 - Proseguire allo **Step 3**

Step 3: SECONDO CONTROLLO - $|V_{DS}|$ vs V_{OV}

Tensione di Overdrive:

$$V_{OV} = |V_{GS}| - |V_T|$$

- ZONA DI SATURAZIONE:** Se $|V_{DS}| > V_{OV}$

$$I_D = K_p \cdot V_{OV}^2 = K_p (|V_{GS}| - |V_T|)^2$$

Nota: La corrente dipende **SOLO** dall'overdrive

- ZONA OHMICA (Triodo):** Se $|V_{DS}| < V_{OV}$

$$I_D = K_p \left[2V_{OV} \cdot |V_{DS}| - |V_{DS}|^2 \right]$$

dove $V_{OV} = |V_{GS}| - |V_T|$

Nota: La corrente dipende da V_{OV} **E** $|V_{DS}|$

Direzione corrente: In pMOS, I_D scorre da **Source** \rightarrow **Drain**

Riepilogo: nMOS vs pMOS

Grandezze da calcolare per determinare lo stato:

nMOS	pMOS
V_{GS}	$ V_{GS} $
V_T	$ V_T $
$V_{OV} = V_{GS} - V_T$	$V_{OV} = V_{GS} - V_T $
V_{DS}	$ V_{DS} $

Controlli identici:

- Se V_{GS} (o $|V_{GS}|$) $< V_T$ (o $|V_T|$) \Rightarrow OFF
- Se ON: confronta V_{DS} (o $|V_{DS}|$) con V_{OV}

La **procedura è identica**, solo che per pMOS si usano i **valori assoluti**.

Parametro K (Transconduttanza)

$$K = \frac{1}{2} \mu \cdot C_{OX} \cdot \frac{W}{L}$$

Dove:

- μ = mobilità dei portatori nel canale
- C_{OX} = capacità specifica dell'ossido
- W/L = dimensioni fisiche del MOSFET (Width/Length)

Δ **NOTA IMPORTANTE - Fattore 1/2**

K può essere definito **SENZA** il fattore $\frac{1}{2}$ al suo interno. In tal caso, le formule delle correnti devono essere **riadattate**:

- Saturazione:**
 $I = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$ invece di $I = K (V_{GS} - V_T)^2$
- Omica:**
 $I = K \left[(V_{GS} - V_T)V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$
invece di $I = K \left[2(V_{GS} - V_T)V_{DS} - V_{DS}^2 \right]$

cMOS

cMOS (Inverter):

1. **Ingresso Alto (logica '1'):**
rete PULL-UP(pMOS ON SAT, nMOS OFF)

nMOS: $V_{GS} > V_{th}$ (Conduzione)

pMOS: $V_{GS} > V_{TP}$ (Cutoff)

Uscita: GND (logica '0')

2. **Ingresso Basso (logica '0'):**
rete PULL-DOWN(nMOS ON SAT, pMOS OFF)

nMOS: $V_{GS} < V_{th}$ (Cutoff)

pMOS: $V_{GS} < V_{TP}$ (Conduzione)

Uscita: VDD (logica '1')

3. **Zona intermedia: entrambi in saturazione**
[.....]

[grafico delle caratteristiche]
cMOS

AND/nAND

AND (AND/nAND):

1. **Entrata:**
 $A = 0, B = 0$
Uscita: 0
2.
 $A = 0, B = 1$
Uscita: 0
3.
 $A = 1, B = 0$
Uscita: 0
4.
 $A = 1, B = 1$
Uscita: 1

OR/nOR

OR (nOR):

1. **Entrata:**
 $A = 0, B = 0$
Uscita: 0
2.
 $A = 0, B = 1$
Uscita: 1
3.
 $A = 1, B = 0$
Uscita: 1
4.
 $A = 1, B = 1$
Uscita: 1

XOR/nXOR

XOR (nXOR):

1. **Entrata:**
 $A = 0, B = 0$
Uscita: 0
2.
 $A = 0, B = 1$
Uscita: 1
3.
 $A = 1, B = 0$
Uscita: 1
4.
 $A = 1, B = 1$
Uscita: 0

Box 17

Box 18

Box 19

Box 20

Box 21

Box 22

Box 23